

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-358086

(P2001-358086A)

(43) 公開日 平成13年12月26日 (2001. 12. 26)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

H 0 1 L 21/22  
21/324

識別記号

5 1 1

F I

H 0 1 L 21/22  
21/324

テーマコード\* (参考)

5 1 1 G  
Q

審査請求 有 請求項の数 4 O L (全 4 頁)

(21) 出願番号 特願2000-181065 (P2000-181065)

(22) 出願日 平成12年6月16日 (2000. 6. 16)

(71) 出願人 000002118

住友金属工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

(72) 発明者 久富 健博

佐賀県杵島郡江北町大字上小田2201番地

住友金属工業株式会社シチックス事業本部  
内

(72) 発明者 足立 尚志

佐賀県杵島郡江北町大字上小田2201番地

住友金属工業株式会社シチックス事業本部  
内

(74) 代理人 100075535

弁理士 池条 重信 (外1名)

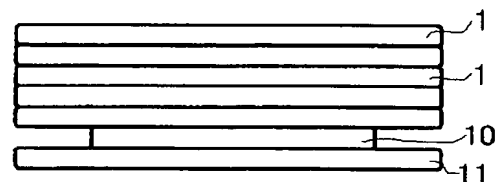
(54) 【発明の名称】 ウェーハの熱処理方法とその装置

(57) 【要約】

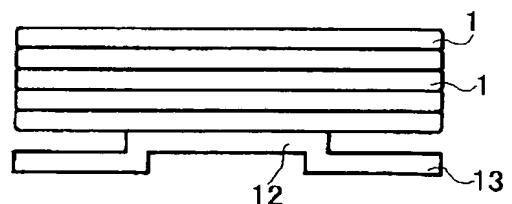
【課題】 例えば1300℃以上の高温下でシリコン単結晶ウェーハを複数枚積載して熱処理を施す際に、ウェーハ内のスリップ転位欠陥の発生防止できる熱処理方法と装置の提供。

【解決手段】 支持板11上に熱処理を施すシリコン単結晶ウェーハより径が小さい載置用のシリコンウェーハ10を介して、その上に被熱処理シリコン単結晶ウェーハ1を1枚又は多数積載して熱処理するか、中央部に同心円状凸部12を設けたウェーハ状又はリング形状の支持板13を用いることにより、従来からの量産規模の熱処理においても、量産効率を何ら疎外することなく、ウェーハにスリップ転位が発生するのを防止できる。

A



B



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 被処理ウェーハの外径より小径のリング状又は円板状の凸部上に1枚又は積層した被処理ウェーハを載置して熱処理するウェーハの熱処理方法。

【請求項2】 1枚又は積層した被熱処理ウェーハを載置支持する手段を有する装置であって、被処理ウェーハの外径より小径のリング状又は円板状の凸部からなる載置部を有するウェーハの熱処理装置。

【請求項3】 載置のための円板状凸部が、シリコンウェーハまたはSiCウェーハである請求項2に記載のウェーハの熱処理装置。

【請求項4】 SiC製円板状の支持手段に載置部を一体成形した請求項2に記載のウェーハの熱処理装置。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】この発明は、例えば、縦型熱処理炉等で積層載置したシリコン単結晶ウェーハを熱処理する方法の改良に係り、該ウェーハの中央部にのみに接触するシリコンウェーハ等の円板状凸部あるいはリング状凸部を設けた熱処理装置を用いることにより、積層載置したウェーハ内にスリップ転位欠陥が発生するのを防止したウェーハの熱処理方法とその装置に関する。

【0002】

【従来の技術】一般に、シリコン単結晶ウェーハなどの半導体ウェーハは、ウェーハ製造工程及びデバイス工程にて複数枚同時に熱処理（バッチ処理）が施される。使用される熱処理炉としては縦型や横型方式があり、縦型炉の場合、半導体ウェーハ1を縦方向に複数の溝部3を有する熱処理ポート2に載せて熱処理を施す構成になっている（図2A参照）。

【0003】しかし、ポート2の支持溝部3において、ウェーハ1を載置した際の最大自重応力が生じ、図3に示すごとく、ウェーハ1内にスリップ転位欠陥5が発生する問題がある。

【0004】かかる欠陥の抑制手段として、熱処理に際してシリコン単結晶ウェーハ1の下部にウェーハの反りを防止するため、図2Aに示すごとく、ダミーウェーハまたはリング形状の支持板4を用い、これに載置して自重応力を低減させてスリップ発生を抑制する方法（特開平9-50967号、特開平10-270369号）が数多く提案されている。

【0005】一般に、シリコン単結晶ウェーハに対して1200℃以上の熱処理を行う際に用いられる支持板として、高温強度に優れたSiC（シリコンカーバイド）製の支持板を用いることは効果的で、特に自重応力が大きい200mmφ以上のシリコン単結晶ウェーハ、あるいは複数枚積層したシリコン単結晶ウェーハの熱処理に用いると有効である。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】しかし、例えば1300℃以上の高温下でシリコン単結晶ウェーハを複数枚積層し

て熱処理を施す場合、ウェーハ1が全面接触するように支持して作製したシリコン単結晶ウェーハでは、X線トポグラフ装置を用いて、ウェーハ内のスリップ転位欠陥発生の調査を行ったところ、スリップの発生頻度は高くなることが判明した。

【0007】この発明は、上述の高温下でシリコン単結晶ウェーハを複数枚積層して熱処理を施す際に、ウェーハ内のスリップ転位欠陥の発生防止できる熱処理方法とその装置の提供を目的としている。

【0008】

【課題を解決するための手段】発明者らは、前記問題の原因を考察、調査した結果、1300℃以上の高温下での熱処理では、複数枚積層したシリコン単結晶ウェーハあるいは200mmφ以上の径の単一のシリコン単結晶ウェーハに対し、前述のようなSiC製の平状支持板を用いると、図2Bに示すごとく、シリコン単結晶ウェーハ1の自重によりSiC製の平状支持板4は下方凹状に反り、これによってシリコン単結晶ウェーハ1の外周端で局所的な接触支持になり、図3に示すようにシリコン単結晶ウェーハ1外周端を起点としてスリップ転位欠陥5が多発することを確認した。

【0009】さらにここで、SiC製平状支持板の厚みを1mm以上増加させて、スリップ転位の発生防止を図ったところ、逆に支持板の厚み増加に伴う熱容量増加によりシリコン単結晶ウェーハとSiC製平状支持板間での温度勾配が大きくなり、スリップ転位が発生した。

【0010】そこで発明者らは、高温熱処理によるスリップの発生防止可能な支持方法の条件出しを種々検討した結果、支持板上に熱処理を施すシリコン単結晶ウェーハより径が小さいシリコンウェーハを載置し、その上に熱処理を施すシリコン単結晶ウェーハを1枚あるいは2枚以上積層した状態で熱処理を行うことで、スリップの抑制が可能であることを知見し、この発明を完成した。

【0011】すなわち、この発明は、1枚又は積層した被処理ウェーハを熱処理するに際して、被処理ウェーハのウェーハ外径より小さな外径を有するリング状又は円板状凸部上に載置することを特徴とするウェーハの熱処理方法である。

【0012】また、この発明は、1枚又は積層した被熱処理ウェーハを載置支持する手段を有する装置であって、被処理ウェーハの外径より小径のリング状又は円板状の凸部からなる載置部を有することを特徴とするウェーハの熱処理装置である。

【0013】

【発明の実施の形態】この発明は、簡易的には図1Aに示すごとく、被処理シリコン単結晶ウェーハ1より径が小さい載置用ウェーハ10を載置する、すなわち被処理ウェーハ1の中央部を支持して単数又は複数を積層載置することにより、高温熱処理時にウェーハ1外周端を起点として発生するスリップ転位欠陥を抑制することの特徴と

する。

【0014】発明者らは、被熱処理ウェーハ径が200mmφの場合、その下部に載置するシリコン単結晶製の載置用ウェーハ径を100～150mmφ間で適正調査を行ったところ、150mmφ未満の径では、該ウェーハが積載方向に突起して変形するためスリップ転位が多発し、150mmφでは同様な変形はなく、スリップ転位は発生しないことが判明した。

【0015】該熱処理ウェーハ径が200mmφの場合、下部に載置するシリコンウェーハ径は150mmφが好ましい。また、被熱処理ウェーハ径が300mmφの場合も同様の結果が得られ、下部に載置する載置用ウェーハ径は200mmφが好ましい。従って、載置用ウェーハの外径は、被処理ウェーハの外径より小径で該半径をより大きな外径を有することが必要で、特に被熱処理ウェーハの外径の2/3～3/4の外径を有するものが好ましい。

【0016】この発明において、被熱処理シリコン単結晶ウェーハより径が小さい載置用の単結晶あるいは多結晶のシリコンウェーハは、ある一定使用回数を連続して熱処理に供すると変形し、その上部に積載したシリコン単結晶ウェーハのスリップ発生要因となる。そのため載置用のシリコンウェーハは定期的、例えば5回使用後に新規変換して使用する必要性がある。

【0017】そこで、被熱処理シリコン単結晶ウェーハ下部に設置する、前記の載置用シリコンウェーハの代わりに、耐高温材質、例えばSiC製の支持板あるいはリングで用いたところ、その径はウェーハ径が200mmφの場合、150～195mmφ（被処理ウェーハ外径の75%～97.5%）が好ましいことを知見した。

【0018】一方、載置用の異種のシリコンウェーハを積載して熱処理を行う場合では、熱処理前後にウェーハ積載・分離工程があり、機械にて自動積載及び分離を行うと、工程の機構が煩雑になる欠点がある。

【0019】そこで、量産時の支持方法を検討したところ、シリコン単結晶ウェーハの支持用平板の形状を一体型に変更することで同様の効果が得られることを知見した。詳述すると、例えば図1Bに示すごとく、ウェーハ状又はリング形状の支持板13の中央部を、熱処理を施す被熱処理シリコン単結晶ウェーハ1より小さい径で同心円状凸部12に隆起させた形状とすることで、ウェーハ積載・分離工程において工程増の何らの要因とはならない。

【0020】ここで、被熱処理シリコン単結晶ウェーハ径が200mmφの場合、上記の支持板11の中央部の凸部12径の適正調査を行った結果、その径は150～195mmφ（被処理ウェーハ外径の75%～97.5%）が好ましいことを知見した。なお、凸部12高さは特に限定しないが、前述のごとく高いとスリップ転位の発生の要因となる。

【0021】この発明において、熱処理装置は、簡易的には径が小さい単結晶または多結晶シリコンからなる載置用ウェーハを支持板に載せた構成を採用することができる。

この載置用ウェーハの支持手段には、単なる支持板の他、採用する移載方法や手段に応じて適宜その構成を変更できる。

【0022】また、熱処理装置は、前述の同心円状凸部やリング状凸部を中央部に設けた支持板の他、採用する移載方法や手段に応じて選定される種々の支持具、支持装置に前記の同心円状凸部やリング状凸部を設けて、同部に被熱処理シリコン単結晶ウェーハを単数又は複数載置できる構成を採用できる。

【0023】要するに、1200℃以上でシリコン単結晶ウェーハの熱処理を行う場合、簡易的には径が小さい単結晶または多結晶シリコンウェーハからなる支持板あるいはSiC製の支持板あるいはリングを使用することが有効であり、長期的な例えば、量産時の熱処理には図1Bに示すような、段付き支持板を具備した熱処理装置の使用が有効である。

【0024】

【実施例】実施例1

図1Aに示すごとく、外径200mmφのSiC製支持板11の上に、載置用ウェーハ10として外径150mmφシリコン単結晶ウェーハを載置した後、複数枚の200mmφシリコン単結晶ウェーハ1を載置して、1300℃、2時間の熱処理を行った。

【0025】この発明による熱処理方法にて作製したシリコン単結晶ウェーハでは、X線トポグラフ装置を用いて、ウェーハ内のスリップ転位欠陥発生の調査を行ったところ、複数枚積載したシリコン単結晶ウェーハは全てスリップ転位欠陥が観察されなかった。

【0026】実施例2

耐熱強度に優れた外径200mmφSiC製リング状支持板において、その中央部を150mmφ同心円状に凸部に1mm隆起させた一体型支持板を作製した。この支持板に複数枚の200mmφシリコン単結晶ウェーハを載置して、1300℃、2時間の熱処理を行った。

【0027】この発明による熱処理方法にて作製したシリコン単結晶ウェーハでは、X線トポグラフ装置を用いて、ウェーハ内のスリップ転位欠陥発生の調査を行ったところ、複数枚積載したシリコン単結晶ウェーハは全てスリップ転位欠陥が観察されなかった。

【0028】比較例

複数枚の外径200mmφシリコン単結晶ウェーハを、外径200mmφSiC製支持板上に載置して、1300℃、2時間の熱処理を行った。従来の熱処理方法にて作製したシリコン単結晶ウェーハは、X線トポグラフ装置を用いて、ウェーハ内のスリップ転位欠陥発生の調査を行ったところ、複数枚積載したシリコン単結晶ウェーハの下部側ウェーハに、図3に示すようにウェーハ1外周端を起点とするスリップ転位欠陥5が発生しているのを観察した。

【0029】

【発明の効果】この発明は、シリコン単結晶ウェーハ、

特に自重応力の大きい外径が200mmφ以上のシリコン単結晶ウェーハを単数又は積層してこれを1200℃以上の高温下で所要の熱処理を行うに際し、支持板上に小径の載置用シリコンウェーハを介して被処理ウェーハを載置するため、被処理ウェーハにスリップ転位が発生するのを防止できる。

【0030】また、この発明は、図1Bに示すような中央部に同心円状凸部を設けたウェーハ状又はリング形状の支持板を備えた熱処理装置を使用することにより、従来からの量産規模の熱処理においても、量産効率を何ら疎外することなく、ウェーハにスリップ転位が発生するのを防止できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明によるシリコン単結晶ウェーハの熱処理方法を示すウェーハと支持板の組み合わせを示す説明図であり、Aは、支持板の上に載置用の小径のシリコン単結晶ウェーハを介して複数枚積載したシリコン単結晶ウェーハを示し、Bは、シリコン単結晶ウェーハと中央

部凸状の段付きSiC製支持板との組み合わせを示す。

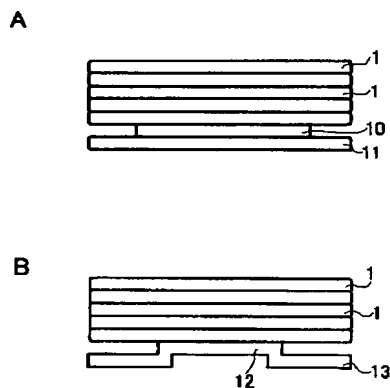
【図2】Aは、シリコン単結晶ウェーハの熱処理に際して縦型熱処理ポートを使用した場合のウェーハと支持板の組み合わせを示す説明図である。Bは、熱処理に際して複数枚を積載したシリコン単結晶ウェーハとその下部に設置し支持板の組み合わせを示す説明図である。

【図3】シリコン単結晶ウェーハのX線トポグラフに観察した際に見られるスリップ転位の概略説明図である。

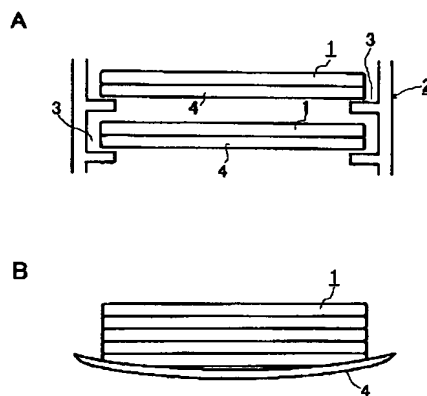
【符号の説明】

- 1 ウェーハ
- 2 ポート
- 3 溝部
- 4 支持板
- 5 スリップ転位欠陥
- 10 載置用ウェーハ
- 11, 13 支持板
- 12 凸部

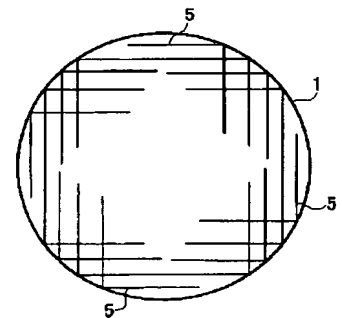
【図1】



【図2】



【図3】



# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-358086

(43)Date of publication of application : 26.12.2001

(51)Int.Cl.

H01L 21/22  
H01L 21/324

(21)Application number : 2000-181065

(71)Applicant : SUMITOMO METAL IND LTD

(22)Date of filing : 16.06.2000

(72)Inventor : HISATOMI TAKEHIRO  
ADACHI HISASHI

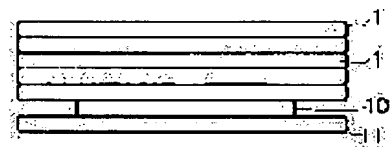
## (54) THERMAL TREATMENT METHOD AND DEVICE OF WAFER

### (57)Abstract:

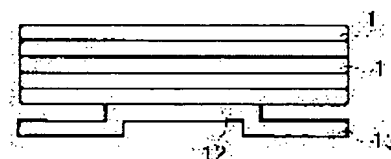
**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a thermal treatment method and device that can prevent a slip displacement defect in a wafer when a plurality of silicon monocrystal wafers are stacked and subjected to heat treatment at a high temperature of 1300°C or more.

**SOLUTION:** Using a silicon wafer 10 for placement that is smaller in diameter than the silicon monocrystal wafer undergoing heat treatment on a support plate 11, one or more silicon monocrystal wafers 1 for heat treatment are placed thereon, and then, heat treatment is carried out. Or a wafer-shaped or ring-shaped support plate 13 having a concentric convex part 12 at the center is used. Therefore, even in conventional heat treatment for mass production, it is possible to prevent slip dislocation on a wafer without efficiency drop in mass production.

A



B



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 31.01.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

**\* NOTICES \***

**JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.**

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

---

**CLAIMS**

---

[Claim(s)]

[Claim 1] The heat treatment approach of the wafer which lays and heat-treats one sheet or the processed wafer which carried out the laminating on the shape of a ring of a minor diameter, and disc-like heights from the outer diameter of a processed wafer.

[Claim 2] The thermal treatment equipment of the wafer which has the installation section which is equipment which has the means which carries out installation support of one sheet or the heat-treated wafer which carried out the laminating, and consists of the shape of a ring and the disc-like heights of a minor diameter from the outer diameter of a processed wafer.

[Claim 3] The thermal treatment equipment of the wafer according to claim 2 whose disc-like heights for installation are a silicon wafer or a SiC wafer.

[Claim 4] The thermal treatment equipment of the wafer according to claim 2 which really fabricated the installation section to the support means disc-like [ made from SiC ].

---

[Translation done.]

**\* NOTICES \***

**JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.**

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

---

**DETAILED DESCRIPTION**


---

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to amelioration of the approach of heat-treating the silicon single crystal wafer which carried out laminating installation for example, with the vertical mold heat treating furnace etc., and relates to the heat treatment approach and the equipment of the wafer which prevented that a slip rearrangement defect occurred in the wafer which carried out laminating installation by using the thermal treatment equipment which prepared the disc-like heights or ring-like heights only in contact with the center section of this wafer, such as a silicon wafer.

[0002]

[Description of the Prior Art] Generally, as for semiconductor wafers, such as a silicon single crystal wafer, heat treatment (batch processing) is performed to two or more sheet coincidence at a wafer production process and a device process. There are a vertical mold and a horizontal-type method as a heat treating furnace used, and when it is a vertical mold furnace, it has composition which heat-treats by putting a semiconductor wafer 1 on the heat treatment boat 2 which has two or more slots 3 in a lengthwise direction (refer to drawing 2 A).

[0003] However, in the support slot 3 of a boat 2, the maximum self-weight stress at the time of laying a wafer 1 arises, and as shown in drawing 3, the problem which the slip rearrangement defect 5 generates is in a wafer 1.

[0004] In order to prevent the curvature of a wafer in the lower part of the silicon single crystal wafer 1 on the occasion of heat treatment as a control means of this defect, as shown in drawing 2 A, many approaches (JP,9-50967,A, JP,10-270369,A) of laying in this, making reduce self-weight stress using the support plate 4 of a dummy wafer or a ring configuration, and controlling slip generating are proposed.

[0005] It is effective to use the support plate excellent in high temperature strength made from SiC (silicon carbide) as a support plate generally used in case heat treatment of 1200 degrees C or more is performed to a silicon single crystal wafer, and if it uses for heat treatment of the silicon single crystal wafer more than 200mmphi especially with large self-weight stress, or the silicon single crystal wafer loaded two or more sheets, it is effective.

[0006]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, when heat-treating by loading two or more silicon single crystal wafers, for example under an elevated temperature 1300 degrees C or more, and slip rearrangement defective generating in a wafer was investigated with the silicon single crystal wafer supported and produced using X-ray topogrph equipment so that a wafer 1 might contact completely, it became clear that the occurrence frequency of a slip became high.

[0007] In case this invention heat-treats by loading two or more silicon single crystal wafers under an above-mentioned elevated temperature, it aims at offer of the heat treatment approach which can carry out generating prevention of the slip rearrangement defect in a wafer, and its equipment.

[0008]

[Means for Solving the Problem] As a result of artificers' considering the cause of said problem and investigating, in heat treatment under an elevated temperature 1300 degrees C or more If the above Taira-like support plates made from SiC are used to the silicon single crystal wafer loaded two or more sheets or the single silicon single crystal wafer of the path more than 200mmphi As shown in drawing 2 B, the Taira-like support plate 4 made from SiC to a down concave with the self-weight of the silicon single crystal wafer 1 Curvature, It became local contact support at the periphery edge of the silicon single crystal wafer 1 by this, and checked that the slip rearrangement defects 5 occurred frequently with a

silicon single crystal wafer 1 periphery edge as the starting point as shown in drawing 3.

[0009] Furthermore, when the thickness of the Taira-like support plate made from SiC was made to increase by 1mm or more and generating prevention of a slip rearrangement was aimed at, the temperature gradient between a silicon single crystal wafer and the Taira-like support plate made from SiC became large by the increment in heat capacity accompanying the increased thickness of a support plate conversely, and the slip rearrangement occurred here.

[0010] Then, from the silicon single crystal wafer which heat-treats on a support plate as a result of examining various condition \*\*\*\* of the manner of support which the slip by elevated-temperature heat treatment can generating prevent, the path laid the small silicon wafer, and artificers are heat-treating the silicon single crystal wafer which heat-treats on it, one sheet or where two or more sheets' are loaded, did the knowledge of control of a slip being possible, and completed this invention.

[0011] That is, this invention is the heat treatment approach of the wafer characterized by facing heat-treating one sheet or the processed wafer which carried out the laminating, and laying on the shape of a ring which has an outer diameter smaller than the wafer outer diameter of a processed wafer, and disc-like heights.

[0012] Moreover, this invention is equipment which has the means which carries out installation support of one sheet or the heat-treated wafer which carried out the laminating, and is the thermal treatment equipment of the wafer characterized by having the installation section which consists of the shape of a ring and the disc-like heights of a minor diameter from the outer diameter of a processed wafer.

[0013]

[Embodiment of the Invention] This invention lays the wafer 10 for installation with a path smaller than the processed silicon single crystal wafer 1, as shown in drawing 1 A in simple, i.e., it is characterized by controlling the slip rearrangement defect in which a wafer 1 periphery edge is generated as an origin at the time of elevated-temperature heat treatment by carrying out laminating installation of an unit or the plurality in support of the center section of the processed wafer 1.

[0014] In order that this wafer may project and deform artificers in the loading direction for the diameter for installation of a wafer made from a silicon single crystal laid in the lower part with the path of under 150mmphi when they conduct proper investigation between 100-150mmphi when the diameter of a heat-treated wafer is 200mmphi, slip rearrangements occur frequently, there is no deformation same in 150mmphi, and it became clear that a slip rearrangement was not generated.

[0015] When this diameter of a heat treatment wafer is 200mmphi, the diameter of a silicon wafer laid in the lower part has desirable 150mmphi. Moreover, the diameter for installation of a wafer which the same result is obtained also when the diameter of a heat-treated wafer is 300mmphi, and is laid in the lower part has desirable 200mmphi. Therefore, the outer diameter of the wafer for installation needs to have a bigger outer diameter for this radius in a minor diameter, and what has the outer diameter of  $2/3 - 3/4$  of the outer diameter of a heat-treated wafer especially is more desirable than the outer diameter of a processed wafer.

[0016] In this invention, the silicon wafer of the single crystal for installation or polycrystal with a path smaller than a heat-treated silicon single crystal wafer will deform, if heat treatment is continuously presented with a certain fixed use count, and it becomes the slip generating factor of the silicon single crystal wafer loaded into that upper part. Therefore, the silicon wafer for installation has periodical, for example, the need of using it after 5 times use, new-changing.

[0017] Then, when used instead of the aforementioned silicon wafer for installation installed in the heat-treated silicon single crystal wafer lower part in the support plate or ring made from the elevated-temperature-proof quality of the material, for example, SiC, the path carried out the knowledge of 150-195mmphi (75% - 97.5% of a processed wafer outer diameter) being desirable, when the diameter of a wafer was 200mmphi.

[0018] In the case where it heat-treats by loading the silicon wafer of a different kind for installation on the other hand, when wafer loading / separation process is before and after heat treatment and automatic loading and separation are performed by machine, there is a fault to which the device of a process becomes complicated.

[0019] Then, when the manner of support at the time of mass production was examined, the knowledge of the same effectiveness being acquired by changing the configuration of the plate for support of a silicon single crystal wafer into one apparatus was carried out. If it explains in full detail, as shown, for example in drawing 1 B, in wafer loading / separation process, it will not become any factor of the increase of a process by making the center section of the support plate 13 of the shape of a wafer, and a ring configuration into the configuration which upheaved the concentric circle-like heights 12 with the path



smaller than the heat-treated silicon single crystal wafer 1 which heat-treats.

[0020] Here, when the diameter of a heat-treated silicon single crystal wafer is 200mmphi, as a result of conducting proper investigation of heights 12 path of the center section of the above-mentioned support plate 11, the path carried out the knowledge of 150-195mmphi (75% - 97.5% of a processed wafer outer diameter) being desirable. In addition, although not limited, if especially heights 12 height is high like the above-mentioned, it will cause generating of a slip rearrangement.

[0021] In this invention, the configuration in which the path put the wafer for installation which consists of a small single crystal and polycrystalline silicon on the support plate in simple can be used for a thermal treatment equipment. According to the transfer approach to adopt besides a mere support plate, or a means, that configuration can be suitably changed into the support means of this wafer for installation.

[0022] Moreover, a thermal treatment equipment prepares aforementioned concentric circle-like heights and ring-like heights in the various support and means for supporting which are selected according to the transfer approach to adopt besides [ which prepared above-mentioned concentric circle-like heights and ring-like heights in the center section ] a support plate, or a means, and can adopt as the said division an unit or the configuration which can be laid for a heat-treated silicon single crystal wafer.

[0023] In short, when heat-treating a silicon single crystal wafer above 1200 degrees C, it is effective that a path uses in simple the support plate, the support plate made from SiC, or ring which consists of a small single crystal and a polycrystalline silicon wafer, and use of the thermal treatment equipment possessing a support plate with [ long-term ] a stage as shown in heat treatment at the time of mass production at drawing 1 B, for example is effective.

[0024]

[Example] As shown in example 1 drawing 1 A, after laying an outer-diameter [ of 150mm ] phi silicon single crystal wafer as a wafer 10 for installation on the support plate 11 made from SiC with an outer diameter [ phi ] of 200mm, two or more 200mmphi silicon single crystal wafers 1 were laid, and 1300 degrees C and heat treatment of 2 hours were performed.

[0025] With the silicon single crystal wafer produced by the heat treatment approach by this invention, when slip rearrangement defective generating in a wafer was investigated using X-ray topogrph equipment, as for all the silicon single crystal wafers loaded two or more sheets, a slip rearrangement defect was not observed.

[0026] In the ring-like support plate made from outer-diameter 200mmphiSiC excellent in example 2 strength in high temperature, the one apparatus support plate which upheaved the center section 1mm to heights in the shape of a 150mmphi concentric circle was produced. Two or more 200mmphi silicon single crystal wafers were laid in this support plate, and 1300 degrees C and heat treatment of 2 hours were performed.

[0027] With the silicon single crystal wafer produced by the heat treatment approach by this invention, when slip rearrangement defective generating in a wafer was investigated using X-ray topogrph equipment, as for all the silicon single crystal wafers loaded two or more sheets, a slip rearrangement defect was not observed.

[0028] The outer-diameter [ of 200mm ] phi silicon single crystal wafer of two or more examples of a comparison was laid on the support plate made from outer-diameter 200mmphiSiC, and 1300 degrees C and heat treatment of 2 hours were performed. When the silicon single crystal wafer produced by the conventional heat treatment approach investigated slip rearrangement defective generating in a wafer using X-ray topogrph equipment, it observed that the slip rearrangement defect 5 on the basis of a wafer 1 periphery edge had occurred as shown in the lower part side wafer of the silicon single crystal wafer loaded two or more sheets at drawing 3.

[0029]

[Effect of the Invention] This invention can prevent that a slip rearrangement generates [ the large outer diameter of a silicon single crystal wafer, especially self-weight stress ] the silicon single crystal wafer more than 200mmphi to a processed wafer an unit or in order to carry out a laminating, to face this performing heat treatment necessary in the bottom of an elevated temperature 1200 degrees C or more and to lay a processed wafer through the silicon wafer for installation of a minor diameter on a support plate.

[0030] Moreover, this invention can prevent that a slip rearrangement occurs to a wafer, without alienating mass-production effectiveness in any way also in heat treatment of the mass-production scale from the former by using the thermal treatment equipment equipped with the support plate of the shape of a wafer and the ring configuration where concentric circle-like heights were prepared in the center section as shown in drawing 1 B.

---

[Translation done.]

## \* NOTICES \*

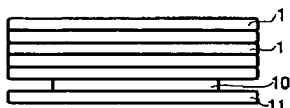
JPO and NCIPi are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

## DRAWINGS

[Drawing 1]

A



B

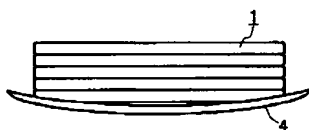


[Drawing 2]

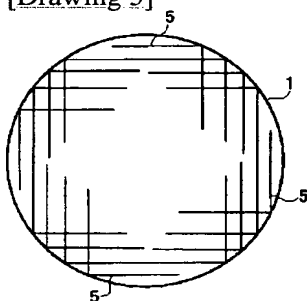
A



B



[Drawing 3]



[Translation done.]